

**关键指标**

频率: DC~20GHz  
 插入损耗: 1.2dB  
 隔离度: 50dB  
 电源电压: -5V  
 控制电平: 0/+5V  
 芯片尺寸: 1.26mm×1.27mm×0.1mm

**产品简介**

HG127KB 是一款 DC~20GHz 反射式单刀双掷开关芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 插入损耗为 1.2dB, 隔离度为 50dB。

**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=-5V)**

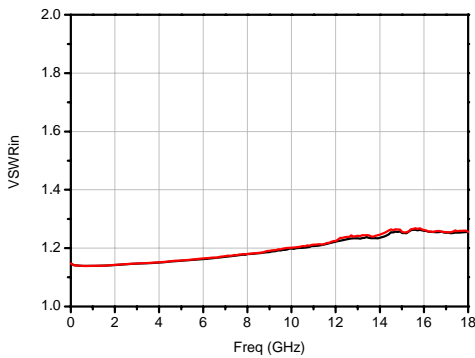
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~20		
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	1.2	-
隔离度(dB)	-	50	-

**真值表 (0: 0V, 1: +5V)**

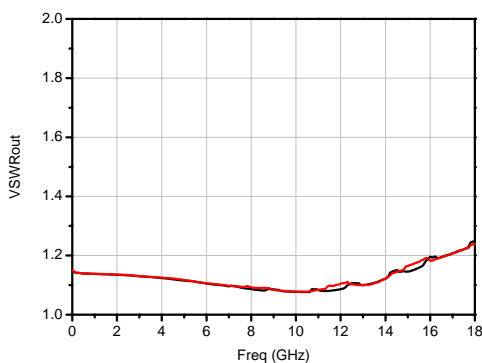
SW	RFC to RF1	RFC to RF2
0	ON	OFF
1	OFF	ON

**典型测试曲线**

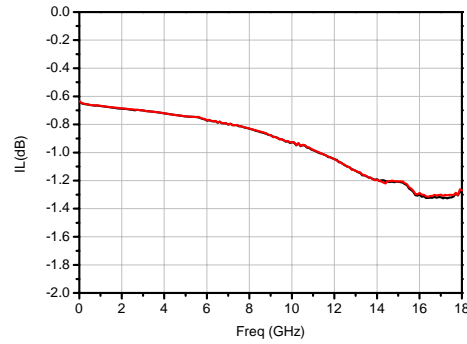
输入驻波



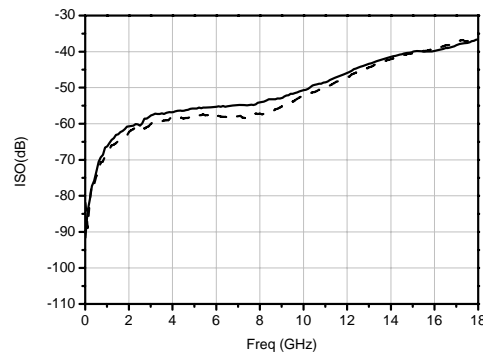
输出驻波



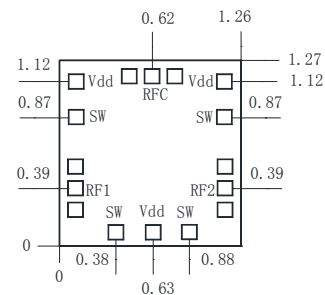
插入损耗



隔离度



**外形和端口尺寸 (mm)**



**绝对额定最大值**

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	-5.5V	
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.7~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

**注意事项**

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。